

Rys. 1-1042. SM103

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: RFT

Wykonanie: tranzystor polowy MOS (kanał typu N, normalnie załączony) o dużej impedancji wejściowej w obudowie plastikowej, płytka krzemowa połączona wewnątrz obudowy ze źródłem, ciężar około 0,3 G

Zastosowanie: do ogólnego stosowania

Typy podobne: KF520 (Tesla), 3SK21 (Hit)

Wartości charakterystyczne¹⁾

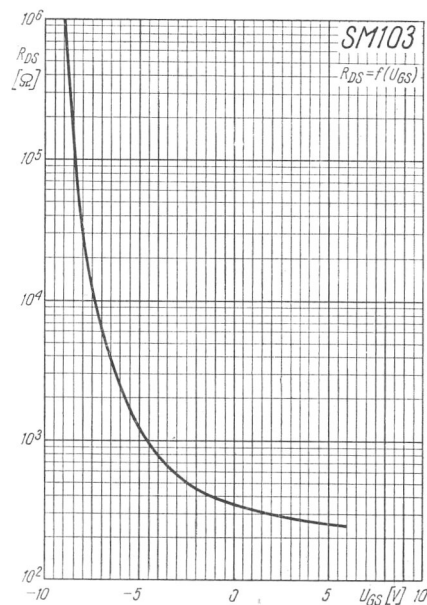
	min	typ	max		
$U_{(BR)DSV}$	20			V	przy $-U_{GS} = 12$ V, $I_D = 10$ μ A
$-U_T$		7,5	12	V	przy $U_{DS} = 8$ V, $I_D = 10$ μ A
$-I_D$	3	7,5	12	mA	przy $U_{DS} = 8$ V, $U_{GS} = 0$
R_i	10^{12}	10^{14}		Ω	przy $-U_{GSS} = 10$ V
C_{11s}		5,5	6,5	pF	przy $U_{DS} = 8$ V, $U_{GS} = 0$
τ_{21s}	1,3	1,7		mS	przy $U_{DS} = 8$ V, $U_{GS} = 0$, $f = 1$ kHz

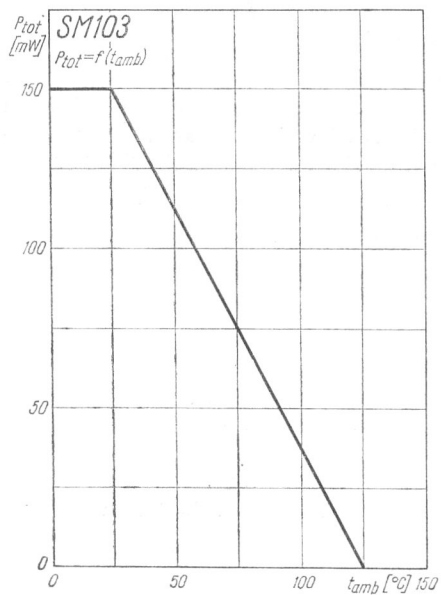
Wartości graniczne

$U_{DSV \max}$	20	V	$P_{tot \max}$	150 ²⁾	mW
$U_{GS \max}$	$-15 \div +5$	V	$t_k \max$	+125	°C
$U_{GD \max}$	32	V	t_{amb}	$-40 \div +125$	°C
$I_D \max$	15	mA	R_{thj-a}	$\leq 0,6$	°C/mW

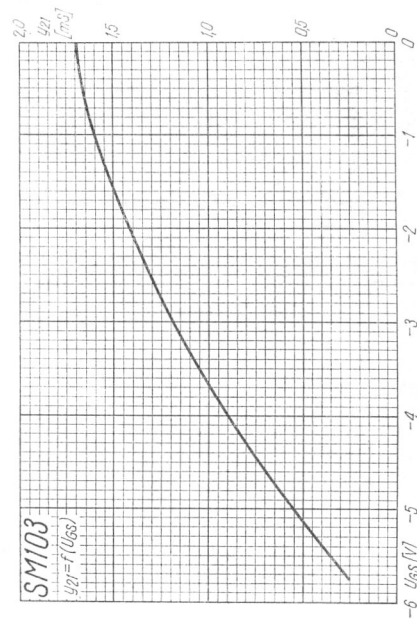
¹⁾ $t_{amb} = 25^\circ\text{C}$ (-5°C)

²⁾ $t_{amb} = 25^\circ\text{C}$

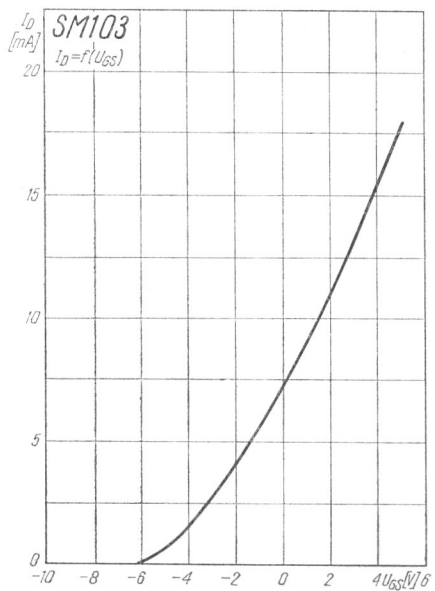
Rys. 1-1043. Zależność R_{DS} od napięcia U_{GS}



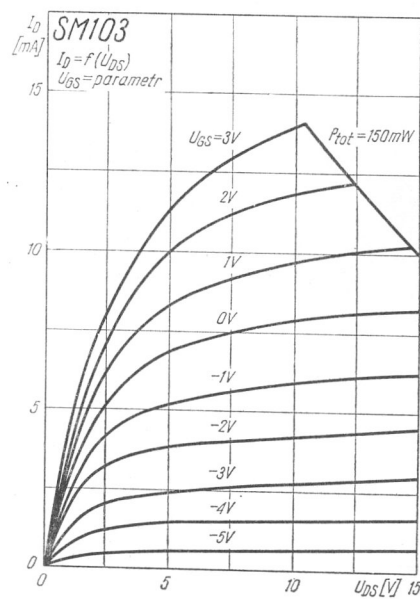
Rys. 1-1044. Zależność dopuszczalnej mocy strat od temperatury otoczenia



Rys. 1-1045. Zależność parametru y_{21} od napięcia bramki



Rys. 1-1046. Charakterystyka przejściowa tranzystora



Rys 1-1047. Charakterystyki wyjściowe